版本更新说明		
版本号	更新日期	更新点:
V1.0	2023.0713	原始版本
V1.1	2023.09.05	更新芯片使用说明

- 1.元器件物料必须保证质量,电容耐压值应大于最大工作电压一倍以上; 2.锂电方案必须带锂保,如果电池不带锂保,硬件设计需添加过流过放电路。
- 3.外露接口和后焊物料: 电池,喇叭等,做好静电和浪涌保护措施,整机ESD应符合最低标准,接触±4K,空气±8K。

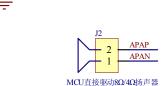


12. APAP, APAN可做IO输出, Ron<IΩ@HPVDD3.7V, 休眠时不可输出, 输出态会导致休眠功耗增加;

13.红外接收管信号IRDA、SPI、IIC、UART、MCPWM支持映射到任意PAn和PBn CPIO、

14.开发升级或使用IT8量产的必要测试点: VBAT, GND, PBI串口升级;

APAP与APAN输出电流总和小于400mA(即HPVDD电流小于400mA),硬件设计时,禁止超出电流限制;



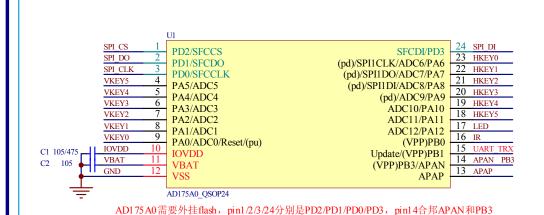
2

3

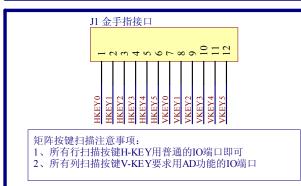
升级/调试

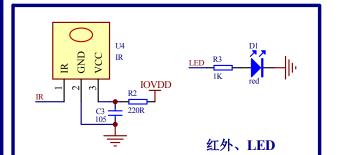
**VBAT** 

UART TRX



**IOVDD** R4 C4 104 10K VCC 2 SPI DI SO/D1 HOLD/D3 IOVDD 3 6 SPI\_CLK  $\overline{\text{WP}}/\text{D2}$ SCK 4 SPI DO **GND** SI/D0 25Qxx 2bit模式spi 外挂flash





矩阵扫描按键

**MCU**